

Family Set:

2 family member for:

JP7297404

Derived from 1 application.

1 MANUFACTURE OF THIN FILM TRANSISTOR

Publication Info: JP3406681B2 B2 - 2003-05-12

JP7297404 A - 1995-11-10

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Best Available Copy

MANUFACTURE OF THIN FILM TRANSISTOR

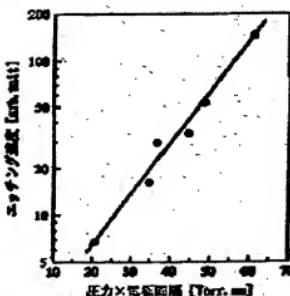
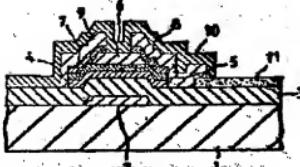
Patent number: JP7297404
 Publication date: 1995-11-10
 Inventor: FUKUDA KAICHI
 Applicant: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO
 Classification:
 - International: G02F1/136; H01L21/31; H01L21/336; H01L29/786;
 G02F1/13; H01L21/02; H01L29/66; (IPC1-7):
 H01L29/786; G02F1/136; H01L21/31
 - European:
 Application number: JP19940084223 19940422
 Priority number(s): JP19940084223 19940422

[Report a data error here](#)

Abstract of JP7297404

PURPOSE: To make etching rate of a channel protective film faster than that of a gate insulating layer by adjusting the product of the gas pressure at the time of forming a channel protective film and the interval between discharge electrodes to a specific multiple of the product of the gas pressure at the time of forming the gate insulating layer and the interval between discharge electrodes.

CONSTITUTION: When the SiNx film 7 of a gate insulating layer 4 is formed, the gas pressure Pg and interval Dg between discharge electrodes are respectively adjusted to 3.5Torr and 14mm and, when the SiN film of a channel protective layer 6 is formed, the gas pressure P_c and interval D_c between electrodes are respectively adjusted to 2.5Torr and 14mm. Thus the product (P_cxD_c=60Torr.mm) of the gas pressure P_c and interval D_c at the time of forming the SiN film of the channel protective layer 6 is made about 1.2 times (1.1-6 times) larger than that (PgxDg=49Torr.mm) of the gas pressure Pg and interval Dg at the time of forming the SiN film of the gate insulating layer 4. From the relation between the product of the gas pressure and interval of discharge electrodes, the etching rate of the SiNx film 7 can be made faster than that of the SiNx film 4.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(51)Int.Cl.*

H01L 29/766

G02F 1/136

H01L 21/31

識別記号

F I

9056-4M

H01L 29/76

311

500

21/31

C

B

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平6-84228

(22)出願日

平成6年(1994)4月22日

(71)出願人

000003078

株式会社東芝

神奈川県横浜市幸区堀川町72番地

(72)発明者

福田 加一

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝横浜事業所内

(74)代理人

弁理士 大畠 真夫

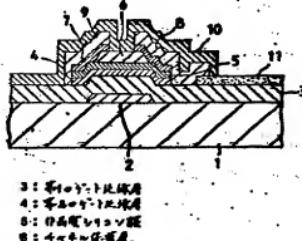
(54)【発明の名称】薄膜トランジスタの製造方法

(57)【要約】

【目的】 プラズマCVD法により同一反応室でゲート絶縁層、このゲート絶縁層と同一組成のチャネル保護層を形成しても、十分なエッキング選択性をもたせることを目的とする。

【構成】 プラズマCVD法によりゲート絶縁層、半導体活性層およびゲート絶縁層と同一成分のチャネル保護層を積層成膜する薄膜トランジスタの製造方法において、そのゲート絶縁層、半導体活性層およびチャネル保護層を同一反応室で連続的に積層成膜し、チャネル保護層を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_cとの積P_g・D_cをゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_gとの積P_g・D_gの1.1倍ないし6倍にした。

【効果】 生産性を向上させることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ブラズマCVD法によりゲート絶縁層、半導体活性層および上記ゲート絶縁層と同一成分のチャネル保護層を積層成膜する薄膜トランジスタの製造方法において、

上記ゲート絶縁層、半導体活性層およびチャネル保護層を同一反応室で連続的に積層成膜し、上記チャネル保護層を成膜するときのガス圧力 P_g と放電電極間隔 D_c との積 $P_g \cdot D_c$ を上記ゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力 P_g と放電電極間隔 D_g との積 $P_g \cdot D_g$ の1.1倍ないし6倍にしたことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

【請求項2】 ブラズマCVD法によりゲート絶縁層、半導体活性層および上記ゲート絶縁層と同一成分のチャネル保護層を積層成膜する薄膜トランジスタの製造方法において、

上記ゲート絶縁層、半導体活性層およびチャネル保護層を同一反応室で連続的に積層成膜し、上記チャネル保護層を成膜するときのガス圧力 P_g を上記ゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力 P_g もりも0.5 Torrないし4 Torr高くしたことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【実業上の利用分野】 この発明は、アクティブマトリックス型液晶表示素子のスイッチング素子などに用いられる薄膜トランジスタの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 液晶を用いた表示素子は、テレビ映像やグラフィックディスプレイなどを指向した大容量、高密度化の点から、たとえばラビングによる配向処理が施された2枚の基板を、配向方向が互いに90°をなすように平行に対向配置し、この対向基板間にネマチックタイプの液晶構成物を持させた、いわゆるツイストネマチック型(TN型)のアクティブマトリックス型液晶表示素子が注目されている。このアクティブマトリックス型液晶表示素子では、クロストークのない高コントラストの表示が得られるように色々な素子の駆動および制御を半導体スイッチング素子でおこなう方式が採用されている。その半導体スイッチング素子としては、透過型の表示が可能であり、また大面积化が容易であるなどの理由から、透明絶縁基板上に形成された非晶質シリコン(a-Si)系の薄膜トランジスタ(TFT)が用いられている。しかもこのa-Si系のTFTには、半導体活性層であるa-Si膜を挟んで、下層にゲート電極、上層にソース電極およびドレイン電極の配設された逆スクガード構造が多く用いられている。

【0003】 この逆スクガード構造a-Si系のTFTとして、ゲート絶縁層である空気化シリコン(SiN_x)膜上に順次半導体活性層であるa-Si膜、チャネル保

護層であるSiN_x膜、低抵抗半導体層であるn(P)ドープa-Si膜を積層し、これらゲート絶縁層のSiN_x膜、a-Si膜、チャネル保護層のSiN_x膜、Pドープa-Si膜を挟んで、下層にゲート電極、上層にソース電極およびドレイン電極の配設されたa-Si膜のTFTがある。

【0004】 このa-Si系のTFTのゲート絶縁層のSiN_x膜、a-Si膜、チャネル保護層のSiN_x膜、Pドープa-Si膜は、純度、純度、一度に6~8枚のガラス絶縁基板をトレインで露出し、このトレインを搬送して連続処理するインライン式ブラズマCVD装置により成膜されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 上記のように、アクティブマトリックス型液晶表示素子は、半導体スイッチング素子としてa-Si系のTFTが用いられている。これまた、このa-Si系のTFTのゲート絶縁層のSiN_x膜、a-Si膜、チャネル保護層のSiN_x膜、Pドープa-Si膜などは、一度に6~8枚のガラス絶縁基板を搭載したトレインを搬送して連続処理するインライン式ブラズマCVD装置により形成されている。しかしこのインライン式ブラズマCVD装置は、直線性にはすぐれているが、基板が巨大で大きな窓スペースが必要である。また搬送トレインにも窓が付いており、この付近部が割れやすくてパティカルの原因となり、歩留が低下する。さらに筐体内部に付着した膜の剥がれを防止するために、定期的に筐体内部の微振を停止して冷却し、クリーニングをねこなう必要がある。そのため、基板の稼働率が低いなどの問題がある。

【0006】 ところで、半導体活性層の分野では、トレインを用いることなく基板のみを搬送して、一つの反応室で1枚づつ基板を処理する枚絞プロセスが主流となっている。通常この枚絞プロセスでは、成膜とブラズマエッチャリングによる反応室のクリーニングとを交互に周回的におこなっている。

【0007】 そこで、近年、大型ガラス絶縁基板を用いるa-Si系のTFTの製造に、この枚絞プロセスを導入する開発が進められている。この枚絞プロセスでは、その処理装置(枚絞式ブラズマCVD装置)を小型化され、設置スペースを小さくすることが可能である。またトレインを用いることなく基板のみを設置するので、パーティクルの発生を抑制できる。さらにブラズマエッチャリングにより反応室をクリーニングすることにより、パーティクルを低減できるばかりでなく、基板の稼働率の大向上が見込まれる。

【0008】 ところで、このような枚絞式ブラズマCVD装置の生産能力をインライン式ブラズマCVD装置と同等以上にするためにね、成膜速度をインライン式ブラズマCVD装置での成膜速度の10倍以上とし、かつ構造を順次層する異なる種類の初期段階を同一反応室で連続的に成

膜することが要求される。たとえば上記TFTのゲート絶縁層のSI N_x膜、a-Si膜、チャネル保護層のSI N_x膜を同一反応室で成膜することが必要である。

【0009】通常インライン式プラズマCVD装置では、異なる種類の薄膜は、それぞれ異なる反応室で成膜する。そのため、ガラス絶縁基板の温度は、各薄膜に感じた温度に独立に制御することができる。

【0010】一方、チャネル保護層は、そのSI N_x膜を成膜したのち、フォトリソグラフィにより光酸(HF)溶液を用いてエッチング加工するので、同一成分からなるゲート絶縁層のSI N_x膜をエッチングしないように、十分なエッチング選択性をもたせることが必要である。このようなエッチング選択性をもたせるために、従来のインライン式プラズマCVD装置では、チャネル保護層のSI N_x膜を成膜するときのガラス絶縁基板の温度を、ゲート絶縁層のSI N_x膜を成膜するときのガラス絶縁基板の温度よりも50°C程度低くして、速いエッチング速度でチャネル保護層を加工するようにしている。しかし枚葉式プラズマCVD装置により、同一反応室でゲート絶縁層のSI N_x膜、a-Si膜、チャネル保護層のSI N_x膜を同時に成膜するときは、上記インライン式プラズマCVD装置で成膜するように、ガラス絶縁基板の温度を変えると、生産性が低下する。したがって一定の温度でゲート絶縁層のSI N_x膜、a-Si膜、チャネル保護層のSI N_x膜を成膜しなければならない。

【0011】この発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、プラズマCVD法により同一反応室でゲート絶縁層、半導体活性層およびゲート絶縁層と同一成分のチャネル保護層を成膜しても、チャネル保護層のエッチング加工に対して、十分なエッチング選択性をもたせることができるとTFTの製造方法を得ることを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】プラズマCVD法によりゲート絶縁層、半導体活性層およびゲート絶縁層と同一成分のチャネル保護層を直層成膜する薄膜トランジスタの製造方法において、ゲート絶縁層、半導体活性層およびチャネル保護層を同一反応室で連続的に積層成膜し、チャネル保護層を成膜するときのガス圧力P_gと放電電圧間隔D_eとの積P_g・D_eをゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力P_gと放電電圧間隔D_gとの積P_g・D_gの1.1倍ないし6倍にした。

【0013】また、チャネル保護層を成膜するときのガス圧力P_gをゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力P_gよりも0.5Torrないし4Torr高くした。

【0014】

【作用】上記のように、チャネル保護層を成膜するときのガス圧力P_gと放電電圧間隔D_eとの積P_g・D_eをゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力P_gと放電電圧

間隔D_gとの積P_g・D_gの1.1倍ないし6倍にしたか、または、チャネル保護層を成膜するときのガス圧力P_gをゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力P_gよりも0.5Torrないし4Torr高くすると、フォトリソグラフィ法により、チャネル保護層をエッティング加工するときのエッチング速度をゲート絶縁層のエッチング速度よりも速くすることができる。それにより、チャネル保護層をエッティング加工するとQ、ゲート絶縁層のエッティングを抑制することができるQ、十分にエッティングの選択性をもたらすことができる。

【0015】

【実施例】以下、図面を参照してこの発明を実施例に基づいて説明する。

【0016】図1にその一実施例に係るアクティブマトリックス液晶表示装置のスイッチング素子として用いられるTFTを示す。このTFTは、ガラス絶縁基板1の主面上に形成されたモリブデンシートルム(Mo-Tu)からなる所定形状のゲート電極2と、このゲート電極2を覆うようにガラス絶縁基板1上に形成された島層0.3μmの酸化シリコン(SiO₂)膜からなる島1のゲート絶縁層3と、上記ゲート電極2に対してこのゲート絶縁層3上に形成された島層0.05μmのSI N_x膜4からなる所定形状の島2のゲート電極4と、このSI N_x膜4上に形成された島層0.06μmのa-Si膜5からなる所定形状の半導体活性層5と、このa-Si膜5上に形成された島層0.3μmのSI N_x膜6からなる所定形状のチャネル保護層6と、このチャネル保護層6および上記a-Si膜5上に形成された島層0.05μmのPドープa-Si膜7からなる所定形状のPの低抵抗半導体層7と、このPドープa-Si膜7のソース領域およびドレイン領域にそれぞれ形成されたクロム(Cr)またはアルミニウム(Al)からなるソース電極8およびドレイン電極9と、上記チャネル保護層のチャネル保護層6、ソース電極8およびドレイン電極9を覆うSI N_x膜10からなる絶縁保護層10とから成りれている。そのソース電極8と、ゲート絶縁層3上に積層されたITO(Indium Tin Oxide)からなる開口部11に接続されている。

【0017】このTFTの製造法、図2(a)に示すように、まずガラス絶縁基板1の主面上にスパッタ法によりMo-Tuからなる金属膜を成膜し、フォトリソグラフィ法によりエッチングして、所定形状のゲート電極2に加工する。つぎにこのゲート電極2の形成されたガラス絶縁基板1を400°Cに加熱し、常圧CVD法により上記ゲート電極2を覆うようにガラス絶縁基板1上に島層0.3μmのSiO₂膜からなる島1のゲート絶縁層3を成膜する。

【0018】つぎに、後述する枚葉式プラズマCVD装置により、図2(b)に示すように、上記ゲート絶縁層3などの形成されたガラス絶縁基板1を350°Cに加熱

し、プラズマCVD法により、同一反応室で順次ゲート絶縁膜3上に膜厚0.05μmのSiN_x膜4、膜厚0.3μmのa-Si膜5、膜厚0.3μmのSiN_x膜6aを逐次的に重層成膜する。つぎにこのSiN_x膜6aを成膜されたガラス絶縁基板1を枚葉式プラズマCVD装置から取出し、フォトリソグラフィ法により上記SiN_x膜6aをHFを主成分とするエッティング浴液でエッティングして、図2(c)に示すように、所定形状のチャネル保護膜6に加工する。

【0019】つぎに、たとえば枚葉式プラズマCVD装置により、上記チャネル保護膜6の形成されたガラス絶縁基板1に膜厚0.05μmのPドープa-Si膜7を成膜する。そしてフォトリソグラフィ法によりエッティングして、このPドープa-Si膜7を所定形状の低抵抗半導体層に加工するとともに、その下層のa-Si膜6およびSiN_x膜4をそれぞれ所定形状の半導体活性層、ゲート絶縁膜に加工する。つぎにこのガラス絶縁基板1にスパッタ法によりITOからなる透明導電膜を成膜し、フォトリソグラフィ法によりこの透明導電膜をエッティングして、ゲート絶縁膜3上の所定位置に圖示範囲11に加工する。

【0020】つぎに上記耐圧電極11などの形成されたガラス絶縁基板1上に、スパッタ法によりCrまたはAlなどからなる金属膜を成膜する。そしてこの金属膜をフォトリソグラフィ法によりエッティングして、図2(d)に示すように、ソース電極8を形成するとともに、ドレイン電極9を形成する。その後、フォトリソグラフィ法により、このソース電極8およびドレイン電極9をマスクとして、これら電極8、9間のチャネル領域にあるPドープa-Si膜7を、図2(e)に示すようにエッティングにより除去する。その後、上記ソース電極7およびドレイン電極8の成膜されたガラス絶縁基板1上に、プラズマCVD法により膜厚0.3μmのSiN_x膜を成膜し、このSiN_x膜をフォトリソグラフィ法によりエッティングして、図1に示したように、ソース電極7、ドレイン電極8およびこれら電極7、8間のチャネル保護膜6をもう一度保護膜を成膜する。

【0021】図3に、上記2のゲート絶縁層のSiN_x膜、半導体活性層のa-Si膜およびチャネル保護膜のSiN_x膜の成膜に用いられる枚葉式プラズマCVD装置の一例を示す。この枚葉式プラズマCVD装置は、中央にガラス絶縁基板を搬送する搬送機構が設けられた真空の共通室13を備え、この共通室13を取囲むように、その周囲に4つの反応室14～17と1つの加熱室18と2つの搬出入室19、20とが設けられていて

る。その各反応室14～17内には、図4に示すように、高周波電源22に接続された高周波電極23およびこの高周波電極23と対向する接地電極24が配置されている。この接地電極24は、昇降機架25により高周波電極23に対して接觸可能となっている。ガラス絶縁基板1は、この接地電極24の高周波電極23との対向面に固定される。またこの接地電極24に14～17内に、固定されたガラス絶縁基板1を所定温度で加熱するヒーター26が設けられている。また各反応室14～16には、シリコン(SiH₄)、水素(H₂)、アンモニア(NH₃)、窒素(N₂)、フルオロ(PhF₃)、堿化室(NF₃)、アルゴン(Argon)などの成膜またはクリーニング用ガスを供給するガス供給装置27、および各反応室14～17内に排気するためのルーツプロワーポンプおよびドライポンプからなる排気装置28が付属されている。一方、共通室13、加熱室18および耐圧電極室19、20には、それぞれN₂ガスを供給するガス供給装置および排気装置が付設されている。

【0022】この枚葉式プラズマCVD装置による図2のゲート絶縁層のSiN_x膜、a-Si膜およびチャネル保護膜のSiN_x膜の成膜時、ガラス絶縁基板をいかずかか一方の搬出入室19または20に搬入し、共通室13を介して加熱室18に搬入して加熱する。約30分加熱したのち、再び共通室13を介して、たとえば反応室14に搬送する。そしてこの反応室14の対向電極24上でガラス絶縁基板を300°Cに加熱し、プラズマCVD法により次順序0.05μmのSiN_x膜(図2のゲート絶縁膜)、膜厚0.05μmのa-Si膜および0.3μmのSiN_x膜(チャネル保護膜)を重層成膜することによりおこなわれる。

【0023】この場合、同一成分の図2のゲート絶縁膜のSiN_x膜およびチャネル保護膜のSiN_x膜は、それぞれ表1に示す成膜条件で成膜する。特にゲート絶縁膜のSiN_x膜をガス圧力P_G 9.5Torr、高周波電極と接地電極との間隔(放電電極間隔D_G) D_G 14mmで成膜するのに対し、チャネル保護膜のSiN_x膜をガス圧力P_G 2.5Torr、放電電極間隔D_G 14mmで成膜し、

P_G · D_G = 6.9Torr · □

P_G · D_G = 6.0Torr · □

と、チャネル保護膜のSiN_x膜を成膜するとそのガス圧力P_Gと放電電極間隔D_Gとの積P_G · D_Gがゲート絶縁膜のSiN_x膜を成膜するとそのガス圧力P_Gと放電電極間隔D_Gとの積P_G · D_Gの約1.2倍としている。

【0024】

	ゲート絶縁層	チャネル保護層
ガス流量 S1 N ₂	400 (sccm) NH ₃ 4000	400 2000 8000
ガス圧力 (Torr)	8.8	8.8
放電電圧 (V)	1500	1500
放電電極間隔 (nm)	1.4	2.4

【0024】なお、上記S1 N₂膜(第2のゲート絶縁層)、a-Si膜およびS1 N₂膜(チャネル保護層)の成膜されたガラス絶縁基板は、共通室12を經て、いずれか一方の搬出室18または19から搬出される。

【0025】また、上記枚葉式プラズマCVD装置では、他の反応室15～17も、反応室14と同様に第2のゲート絶縁層のS1 N₂膜、a-Si膜およびチャネル保護層のS1 N₂膜を並列的に成膜する。

【0026】ところで、上記のようにガラス絶縁基板1の温度を一定にして、ゲート絶縁層のS1 N₂膜4と同一成分のチャネル保護層のS1 N₂膜7を成膜するとき、チャネル保護層のS1 N₂膜7を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_eとの組P_g・D_eを、第2のゲート絶縁層のS1 N₂膜4を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_eとの組P_g・D_eよりも大きくなると成膜すると、図5にS1 N₂膜を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_eとの組P_g・D_eとエッティング速度との関係を示すように、フォトリソグラフィ法によるS1 N₂膜7のエッティング速度をS1 N₂膜4のエッティング速度よりも十分に大きくなることができる。したがって上記のように成膜したのち、フォトリソグラフィ法によるS1 N₂膜7をHFを主成分とするエッティング液によりエッティングしても、S1 N₂膜4のエッティングを抑制して、所要のチャネル保護層に加工することができる。

【0027】なお、上記実施例では、チャネル保護層のS1 N₂膜7を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_eとの組P_g・D_eを、第2のゲート絶縁層のS1 N₂膜4を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_eとの組P_g・D_eの約1.2倍としたが、このP_g

・D_eとP_g・D_eとの関係は、P_g・D_eをP_g・D_eの1.1倍ないし6倍の範囲にすることにより、その結果得られるエッティング速度差にあり、フォトリソグラフィ法によりS1 N₂膜7をエッティングするとS1 N₂膜4のエッティングを抑制して、所要のチャネル保護層に加工することができる。

【0028】つぎに他の実施例について説明する。

【0029】上記実施例では、枚葉式プラズマCVD装置により所定温度に加熱されたガラス絶縁基板にチャネル保護層のS1 N₂膜を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_eとの組P_g・D_e、第2のゲート絶縁層のS1 N₂膜を成膜するときのガス圧力P_gと放電電極間隔D_eとの組P_g・D_eよりも大きくなり成膜したが、これらチャネル保護層のS1 N₂膜および第2のゲート絶縁層のS1 N₂膜は、膜2に成膜するように、ゲート絶縁層のS1 N₂膜を成膜するときの放電電極間隔D_eおよびチャネル保護層のS1 N₂膜を成膜するときの放電電極間隔D_eなどを2.4nmと一定にし、ゲート絶縁層のS1 N₂膜を成膜するときのガス圧力P_gを1.5Torr、チャネル保護層のS1 N₂膜を成膜するときのガス圧力P_gを5Torrと大きくするだけでも、チャネル保護層のS1 N₂膜のエッティング速度よりも大きくなることがで、成膜後、フォトリソグラフィ法によりチャネル保護層のS1 N₂膜7をエッティングすると、第2のゲート絶縁層のS1 N₂膜のエッティングを抑制して、所要のチャネル保護層に加工することができる。

【0030】

【4段目】

	ゲート絶縁層	チャネル保護層
ガス流量 S1 H (ccm) NH N	4.00 2000 3000	400 2000 3000
ガス圧力 (Torr)	1.6	2.6
放電電力 (W)	1500	1500
放電電極間隔 (mm)	24	24

【0031】なお、上記実施例では、

$$Pc - Pg = 2.5 \text{ Torr} - 1.5 \text{ Torr}$$

$$= 1 \text{ Torr}$$

と、チャネル保護層の S1 N_x 膜を成膜するときのガス圧力 P_c を第2のゲート絶縁層の S1 N_x 膜を成膜するときのガス圧力 P_g よりも 1 Torr 高くしたが、この S1 N_x 膜を成膜するときのガス圧力とエッチング速度とは、図6に示す関係にあり、チャネル保護層の S1 N_x 膜を成膜するときのガス圧力 P_c を第2のゲート絶縁層の S1 N_x 膜を成膜するときのガス圧力 P_g よりも 0.6 Torr ないし 4 Torr 高くすることにより、その結果得られるエッチング速度により、フォトリソグラフィ法によりチャネル保護層の S1 N_x 膜をエッチングするとき、第2のゲート絶縁層の S1 N_x 膜のエッチングを抑制して、所要のチャネル保護層に加工することができる。

【0032】なお、上記各実施例では、アクティブマトリックス型液晶表示素子の TFT について説明したが、この発明は、a-Si 系の密着センサーにも適用可能である。

【0033】

【発明の効果】 プラズマ CVD 法によりゲート絶縁層、半導体活性層、ゲート絶縁層と同一成分のチャネル保護層を順次積層成膜する薄膜トランジスタの製造方法において、チャネル保護層を成膜するときのガス圧力 P_c と放電電極間隔 D_c との積 P_c · D_c をゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力 P_g と放電電極間隔 D_g との積 P_g · D_g の 1.1 倍ないし 6 倍するか、または、チャネル保護層を成膜するときのガス圧力 P_c をゲート絶縁層を成膜するときのガス圧力 P_g よりも 0.6 Torr ないし 4 Torr 高くすると、フォトリソグラフィ法により、チ

20 ャネル保護層をエッチング加工するときのエッチング速度をゲート絶縁層のそれよりも速くすることができる。それにより、チャネル保護層をエッチング加工するととき、ゲート絶縁層のエッチングを抑制して、十分にエッチングの選択性を確保することができる。したがって上記のようにすることにより、ゲート絶縁層、半導体活性層、ゲート絶縁層と同一成分のチャネル保護層を同一反応室で成膜しても、所要の薄膜トランジスタを製造することができ、その生産性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例に係るアクティブマトリックス型液晶表示素子のスイッチング素子として用いられる薄膜トランジスタの構成を示す図である。

【図2】図2(a)ないし(e)はそれぞれ上記薄膜トランジスタの製造方法を説明するための図である。

【図3】この発明の一実施例に係る収容式プラズマ CVD 装置の構成を示す図である。

【図4】上記収容式プラズマ CVD 装置の反応室の構成を示す図である。

【図5】プラズマ CVD 法により空化シリコン膜を成膜するときのガス圧力と電極間隔との関係とエッチング速度との関係を示す図である。

【図6】プラズマ CVD 法により空化シリコン膜を成膜するときのガス圧力とエッチング速度との関係を示す図である。

【符号の説明】

1…ガラス絶縁基板

2…ゲート電極

3…第1のゲート絶縁層

4…第2のゲート絶縁層

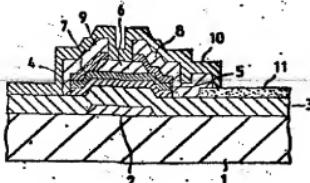
5…非品質シリコン膜(半導体活性層)

50

6…チャネル保護層
7…焼ドープ非晶質シリコン膜(低抵抗半導体膜)
8…ソース電極

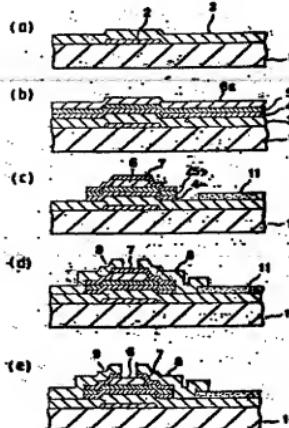
9…トレン電極
10…絶縁保護膜
11…画素電極

【図1】

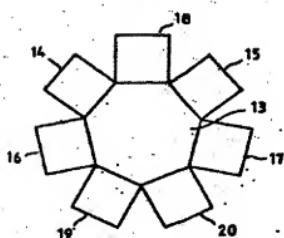


3: 斜り印-トランジistor
4: 斜り印-トランジistor
5: 低抵抗シリコン膜
6: チャネル保護層

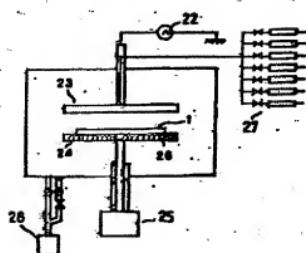
【図2】



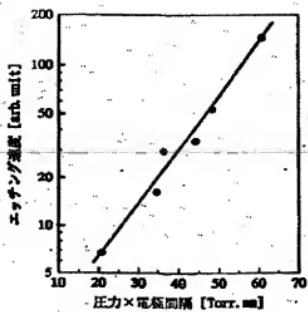
【図3】



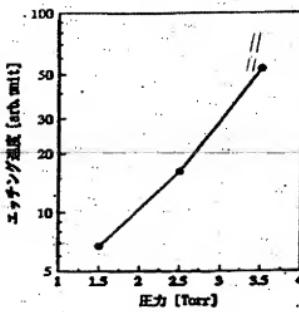
【図4】



【図5】



【図6】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.